

භාෂ්මිකතාව

ඇමීන වල N පරමාණුව මත එකසර ඉලෙක්ට්‍රෝන යුග්ම පවතින බැවින් ඒවාට ලුවීස් හෂ්ම ලෙස ක්‍රියා කල හැකිය.

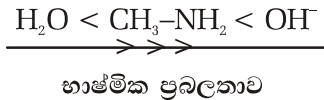
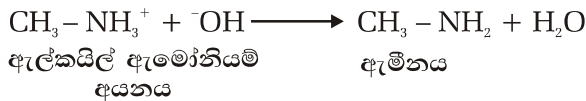
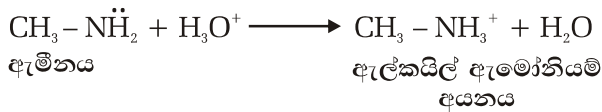
කාබනික රසායනයේ භාෂ්මික සංයෝග ලෙස ක්‍රියා කරනු ලබන්නේ මෙම ඇමීන වේ.

H_3O^+ හෙවත් ජල අණුවක් විසින් H^+ අයනයක් ප්‍රතිග්‍රහණය කර ඇති අවස්ථාවකින් H^+ නිදහස් කරගනිමින් එය ඇමීනය වෙතට ප්‍රතිග්‍රහණය කර ගැනීමට එනම් ඇමීනය ඇල්කයිල් ඇමෝනියම් අයනයක් බවට පත් කර ගැනීමට ඇමීනයට හැකියාව ඇත.

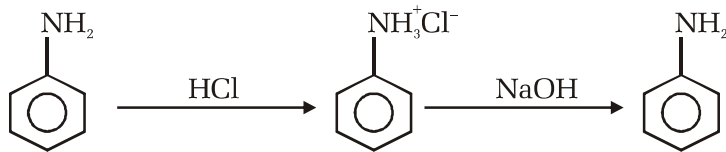
එනම් H^+ ප්‍රතිග්‍රහණය කිරීමේ හැකියාවෙන් හෙවත් භාෂ්මිකතාවයෙන් ඇමීනය ජලයට වඩා ප්‍රභලය.

එමෙන්ම ඇමීනයක් H^+ ප්‍රතිග්‍රහණය කර ඇති අවස්ථාවට හෙවත් ඇල්කයිල් ඇමෝනියම් අයනයක් මගින් H^+ නිදහස් කර ගනිමින් එය ප්‍රතිග්‍රහණය කර ගැනීමට OH^- අයනයකට හැකිය.

එනම් H^+ ප්‍රතිග්‍රහණය කිරීමේ හැකියාවෙන් හෙවත් භාෂ්මිකතාවයෙන් ඇමීනයට වඩා OH^- අයනය ප්‍රභල වේ.

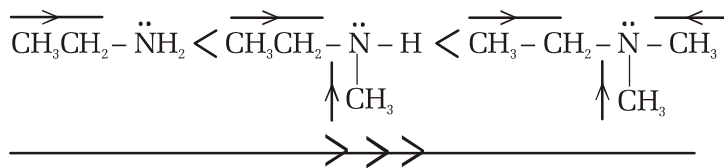


ජලීය මාධ්‍යයකදී ඇමීනයකට අම්ලයක් යෙදූ විට එය ඇමෝනියම් අයනයක් වීමට හා එම ඇමෝනියම් අයනයට ඝෂාරයක් යෙදූ විට නැවත එය මුල් ඇමීනය බවට පත්වීමට හේතුව එය වේ.



I. N පරමාණුව මත පවතින එකසර ඉලෙක්ට්‍රෝන යුග්මය බාහිරට දායක කිරීමේ හැකියාව.

ප්‍රාථමික, ද්විතීයික, තෘතීයික අනුපිළිවෙලට ඇමීන වල ඉලෙක්ට්‍රෝන විකර්ෂක ඇල්කයිල් කාණ්ඩ ගණන වැඩිවන බැවින් එම අනුපිළිවෙලට ඒවායේ N පරමාණුව මත පවතින එකසර ඉලෙක්ට්‍රෝන යුග්මය බාහිරට දායක කිරීමේ හැකියාව වැඩිවේ. ඒ අනුව එම අනුපිළිවෙලට ඇමීනවල භාෂ්මික ප්‍රබලතාවය වැඩි විය යුතු ය.

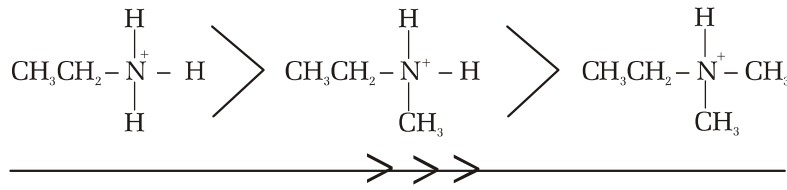


e විකර්ෂක ඇල්කයිල් කාණ්ඩ ගණන වැඩිවේ.
 එකසර e යුග්මය බාහිරට දායක කිරීමේ හැකියාව වැඩිවේ.
 භාෂ්මිකතාව වැඩිවේ.

II. H⁺ ප්‍රතිග්‍රහණය කිරීමෙන් පසු සෑදෙන ඇමෝනියම් අයනයේ සජලන පහසුතාවය

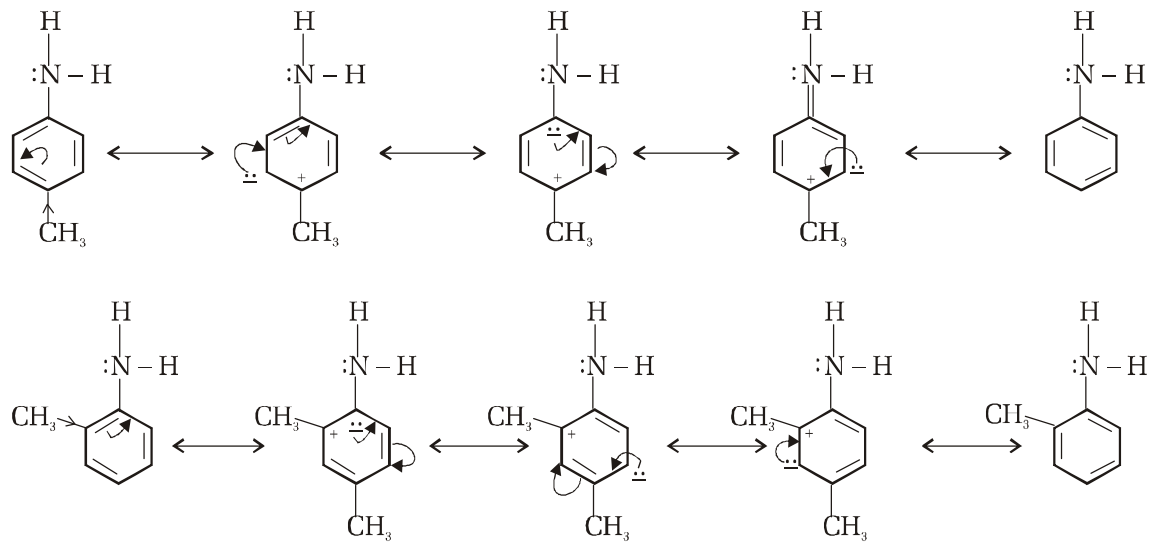
ඇමීනයේ N පරමාණුව මත පවතින එකසර ඉලෙක්ට්‍රෝන යුග්මය දායක කිරීමෙන් හෙවත් ප්‍රෝටෝනයක් (H⁺) ප්‍රතිග්‍රහණය කිරීමෙන් පසු සෑදෙන ඇමෝනියම් අයනයේ සජලන පහසුතාවය වැඩිවත්ම භාෂ්මිකතාව ඉහළ යයි.

ප්‍රාථමික, ද්විතීයික, තෘතීයික ඇමීන H⁺ ප්‍රතිග්‍රහණය කිරීමෙන් පසු සෑදෙන ඇමෝනියම් අයන සැලකූ විට ඒවායේ ඇල්කයිල් කාණ්ඩ ගණන අනුපිළිවෙලින් වැඩිවන බැවින් ත්‍රිමාණ අවහිරතාවය වැඩිවෙමින් එම අනුපිළිවෙලට සජලන පහසුතාවය අඩුවේ. එම නිසා එම අනුපිළිවෙලට ඇමීන වල භාෂ්මිකතාවයද අඩු විය යුතුය. එවිට ඇති වන්නේ පහත ආකාර විචලනයකි.



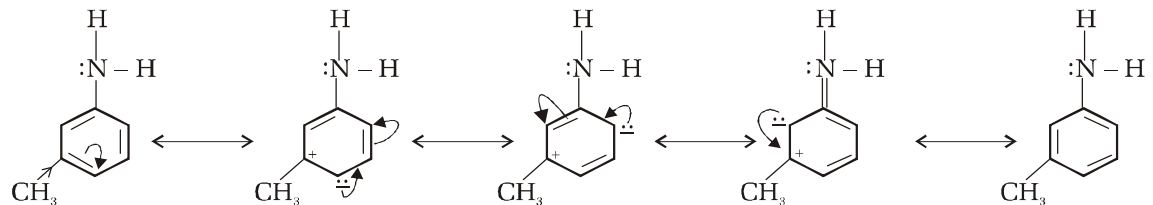
ඇල්කයිල් කාණ්ඩ ගණන වැඩි වීමේදී ත්‍රිමාණ අවහිරතාව වැඩිවේ.
 සජලන පහසුතාව අඩුවේ.
 භාෂ්මිකතාවය අඩුවේ.

චිකර්ෂක කාණ්ඩය ඇතිලීන්ට සම්බන්ධ වී ඇති ස්ථානය අනුව ද එහි බලපෑම වෙනස් වේ. චිකර්ෂක කාණ්ඩයේ පැරා හෝ ඕතෝ ස්ථානවලට බැඳී ඇති විට ඇතිලීන්හි N ට බැඳුණු C පරමාණුව මත සෘණ ආරෝපණයක් ඇතිවන බැවින් එහිදී ඇතිවන චිකර්ෂණය වඩා ප්‍රභල ය. එම නිසා එම අවස්ථාවන් හිදී භාෂ්මිකතාවය වඩාත් ඉහළ වේ.

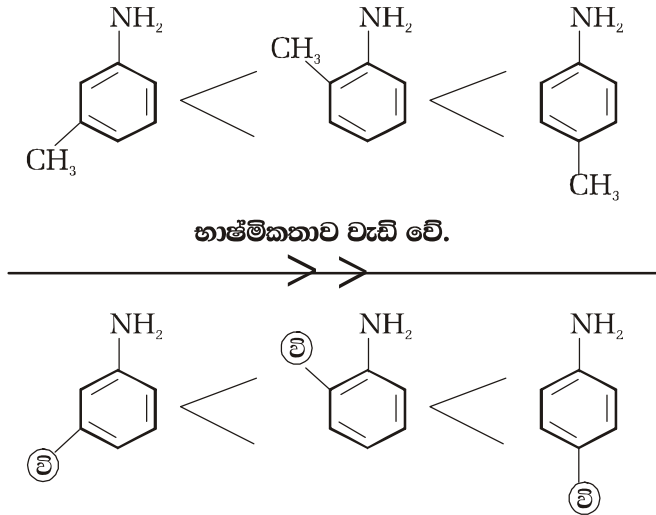


නමුත් චිකර්ෂක කාණ්ඩය මෙටා ස්ථානයට බැඳී ඇති විට එලෙස ඇතිලීන් හි N පරමාණුව බැඳුණු C පරමාණුව මත සෘණ ආරෝපණයක් ඇති නොවන බැවින් එහිදී ඇතිවන චිකර්ෂණය සාපේක්ෂව දුර්වලය.

එනම් චිකර්ෂක කාණ්ඩය මෙටා ස්ථානයේ ඇති විට ඇතිවන භාෂ්මිකතාවය ඕතෝ හා පැරා ස්ථාන වලට වඩා දුර්වල වේ.

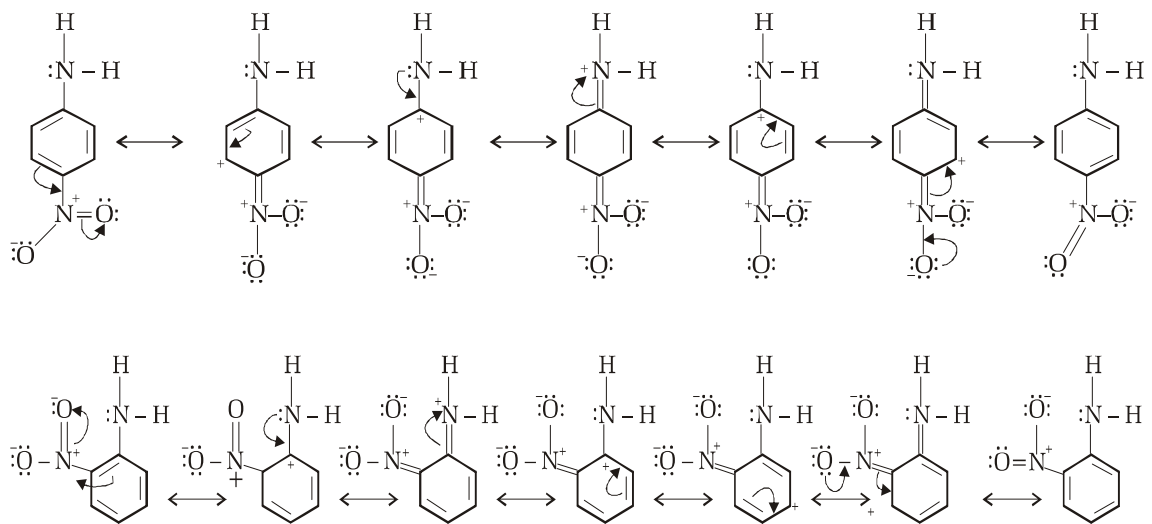


චිකර්ෂක කාණ්ඩය පැරා ස්ථානයේ ඇතිවිට චිකර්ෂක බලපෑම උපරිම වන බැවින් එහිදී භාෂ්මිකතාව වඩාත් ඉහළ වේ.



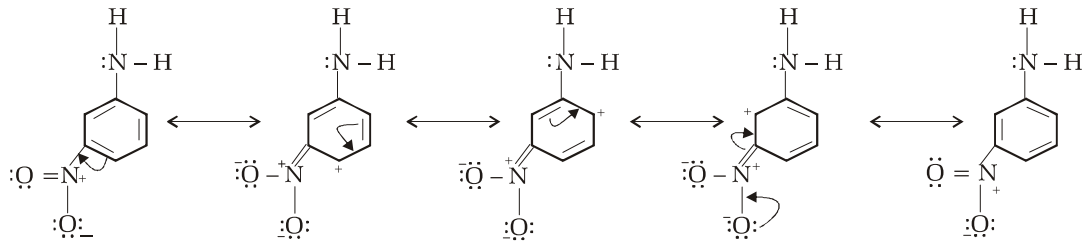
චලෙසටම ආකර්ෂක කාණ්ඩය බැඳී ඇති ස්ථානය අනුවද ඇතිවන්න භාෂ්මිකතාවය වෙනස් වේ.

ආකර්ෂක කාණ්ඩය පැරා හෝ ඕතෝ ස්ථානයකට බැඳී ඇති විට ඇතිවන්න හි N පරමාණුව බැඳී ඇති C පරමාණුව මත + ආරෝපණයක් ඇති වේ. එවිට N පරමාණුව මත ඇති චිකසර ඉලෙක්ට්‍රෝන යුග්මය ආකර්ෂණය කරගැනීමේ හැකියාව වැඩිවන බැවින් චිකසර ඉලෙක්ට්‍රෝන යුග්මය බාහිරට දායක කිරීමේ හැකියාව අඩු වෙමින් භාෂ්මිකතාවය අඩුවේ.

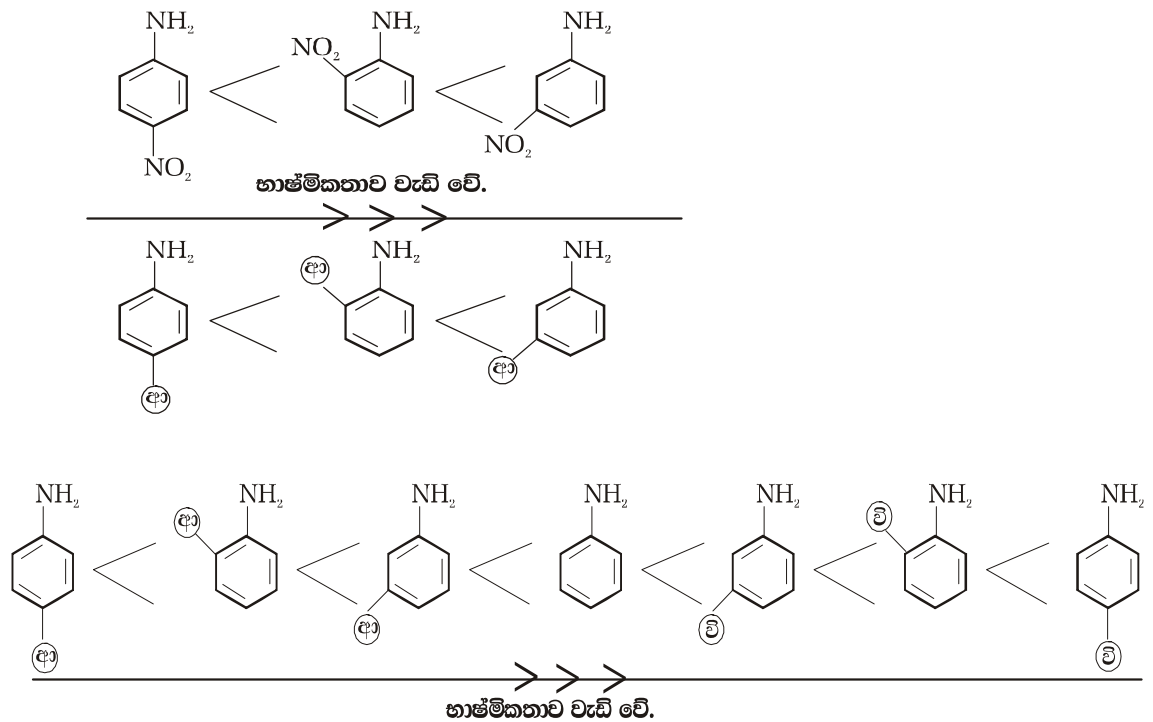


නමුත් ආකර්ෂක කාණ්ඩය මෙටා ස්ථානයේ ඇති විට චලෙස ඇතිවන්න N පරමාණුව බැඳී ඇති C පරමාණුව මත (+) ආරෝපණයක් ඇති නොවන බැවින් එහිදී ආකර්ෂක ගුණය සාපේක්ෂකව අඩු වේ.

විම නිසා ආකර්ෂක කාණ්ඩය මෙලා ස්ථානයේ ඇතිවිට N පරමාණුව මත ඇති විකසර ඉලෙක්ට්‍රෝන යුග්මය බාහිරට දායක කිරීමේ හැකියාව සාපේක්ෂව වැඩි බැවින් අනෙක් අවස්ථාවන්ට සාපේක්ෂව විභි භෂ්මිකතාවය සුළු වශයෙන් වැඩි වේ.

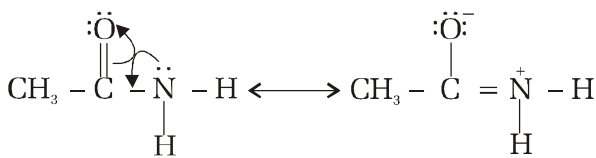


ආකර්ෂක කාණ්ඩය පැරා ස්ථානයේ ඇති විට ආකර්ෂණ ගුණය උපරිම වන බැවින් විභිදී භෂ්මිකතාවය අවම වේ. විමෙන්ම ආකර්ෂක කාණ්ඩය මෙලා ස්ථානයේ ඇතිවිට බලපෑම අවම වන බැවින් සාපේක්ෂව භෂ්මිකතාවය ඉහළම වේ.



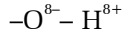
ඇමයිඩ වලදී N පරමාණු මත පවතින විකසර ඉලෙක්ට්‍රෝන යුග්මය කාබනල් කාබන් මත දායක වෙමින් පහත ආකාරයට සම්ප්‍රයුක්ත ව්‍යුහ ඇතිකර ගනී.

විවිධ N පරමාණුව මත පවතින විකසර ඉලෙක්ට්‍රෝන යුග්මය බාහිරට දායක කිරීමේ හැකියාව අඩු වන බැවින් ඇමයිඩ වල භෂ්මිකතාව අවම වේ.



ආම්ලිකතාවය

ආම්ලික සංයෝග වල O - H කාණ්ඩයක් පවතින අතර එය පහත ආකාරයට ධ්‍රැවීකරණය වී පවතී.

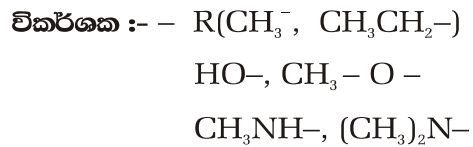
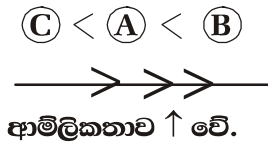
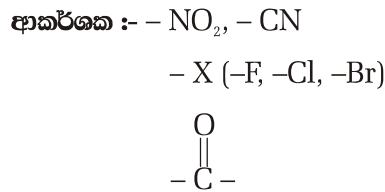
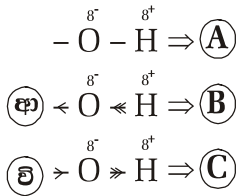


ආම්ලික ප්‍රබලතා සංසන්ධනයේදී සැලකිය යුතු ප්‍රධාන සාධක 2කි.

I. H⁺ ඉවත්වීමේ හැකියාව

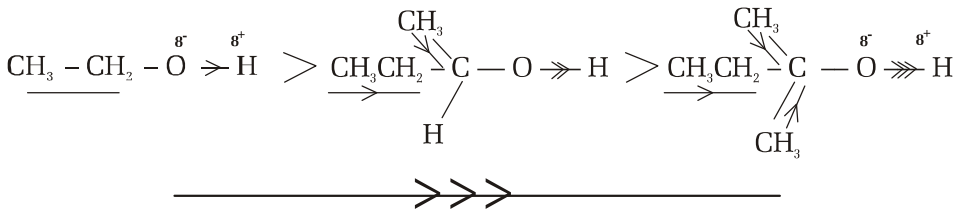
ආකර්ශක කාණ්ඩයක් බැඳී ඇති විට එයින් ඇතිවන ආකර්ෂණ බලපෑම හේතුවෙන් OH කාණ්ඩයේ ධ්‍රැවීකරණය වැඩි වී H⁺ ඉවත් වීමේ හැකියාව වැඩි වේ. එනම් ආම්ලිකතාව වැඩි වේ.

එලෙසටම විකර්ශක කාණ්ඩයක් බැඳී ඇති විට එයින් ඇතිවන විකර්ශණ බලපෑම හේතුවෙන් OH කාණ්ඩයේ ධ්‍රැවීකරණය අඩු වී H⁺ ඉවත්වීමේ හැකියාව අඩුවේ. එවිට ආම්ලිකතාව අඩුවේ.



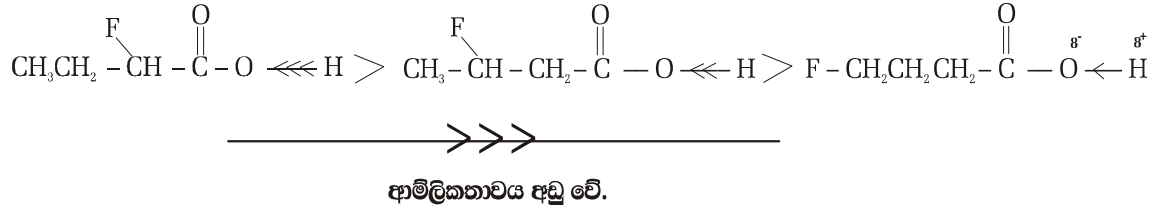
ප්‍රාථමික, ද්විතීයික, තෘතීයික මධ්‍යසාර සැලකූ විට ඒවායේ අනුපිලිවෙලින් ඉලෙක්ට්‍රෝන විකර්ෂක ඇල්කයිල් කාණ්ඩ ගණන වැඩි වන බැවින් OH කාණ්ඩයේ ධ්‍රැවීකරණය අඩු වෙමින් H⁺ ඉවත්වීමේ හැකියාව අඩු වේ.

ඒ අනුව ප්‍රාථමික, ද්විතීයික, තෘතීයික අනුපිලිවෙලට මධ්‍යසාරවල ආම්ලිකතාව අඩු වේ.

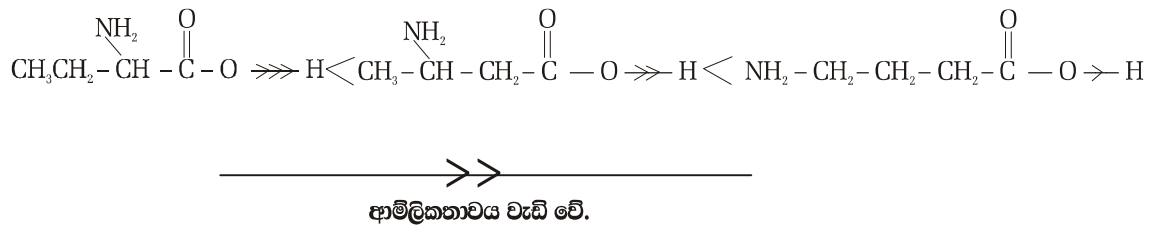


e විකර්ශක ඇල්කයිල් කාණ්ඩ ගණන ↑ වේ.
 -O-H කාණ්ඩයේ ධ්‍රැවීකරණය ↓ වේ.
 H⁺ ඉවත්වීමේ හැකියාව ↓ වේ.
 ආම්ලිකතාවය ↓ වේ.

එමෙන්ම ආකර්ශක කාණ්ඩය OH කාණ්ඩයෙන් අතර යත්ම ආකර්ශක බලපෑම අඩු වන බැවින් කාණ්ඩයේ ධ්‍රැවීකරණය අඩු වෙමින් H⁺ ඉවත්වීමේ හැකියාව අඩු වේ. ඒ අනුව ආම්ලිකතාවය සාපේක්ෂව අඩු වේ.



එලෙසටම විකර්ශක කාණ්ඩයක් OH කාණ්ඩයෙන් අත් වන විට විකර්ශක බලපෑම අඩු වන බැවින් සාපේක්ෂව ආම්ලිකතාව වැඩි වේ.



පහත සංයෝග වල ආම්ලික ප්‍රබලතාව වැඩිවන අනුපිළිවෙලට සංයෝග පෙළ ගස්වන්න.

$$\text{CH}_3\text{CH}_2-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{OH}$$

(a)

$$\text{F}-\overset{\text{F}}{\underset{\text{F}}{\text{C}}}-\text{CH}_2-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{OH}$$

(b)

$$\text{Cl}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{OH}$$

(c)

$$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{OH}$$

(d)

$$\text{F}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{OH}$$

(e)

(b) හි F කාණ්ඩ 3 ක් පවතින බැවින් ආකර්ශක ගුණය වඩා ප්‍රබලය. ආම්ලිකතාව වඩා ප්‍රබලය.

ඉන්පසු එක F කාණ්ඩයක් පමණක් පවතින (e) ප්‍රබලතාවයෙන් ඉහල අතර F ට වඩා Cl හි ආකර්ශක ගුණය අඩු බැවින් (e) ට පසු ආම්ලිකතාවයෙන් ඉහල වන්නේ (c) හි වේ.

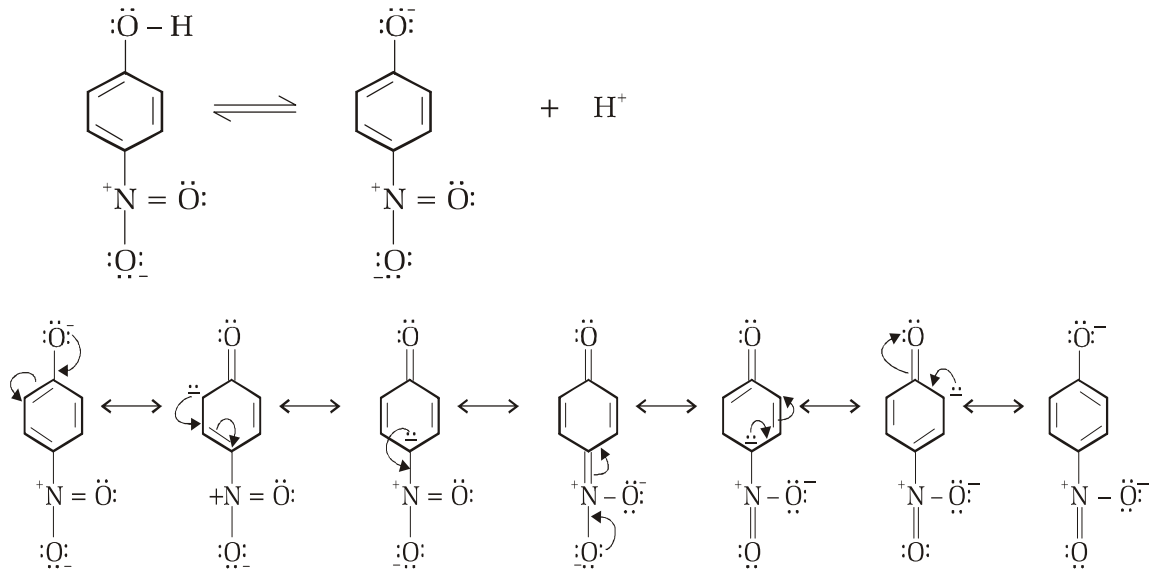
(d) හිදී C දාමය දිගින් වැඩි වන බැවින් විකර්ශක ගුණය ප්‍රබලම වේ. එහි ආම්ලිකතාව අවම වේ.

d < a < c < e < b

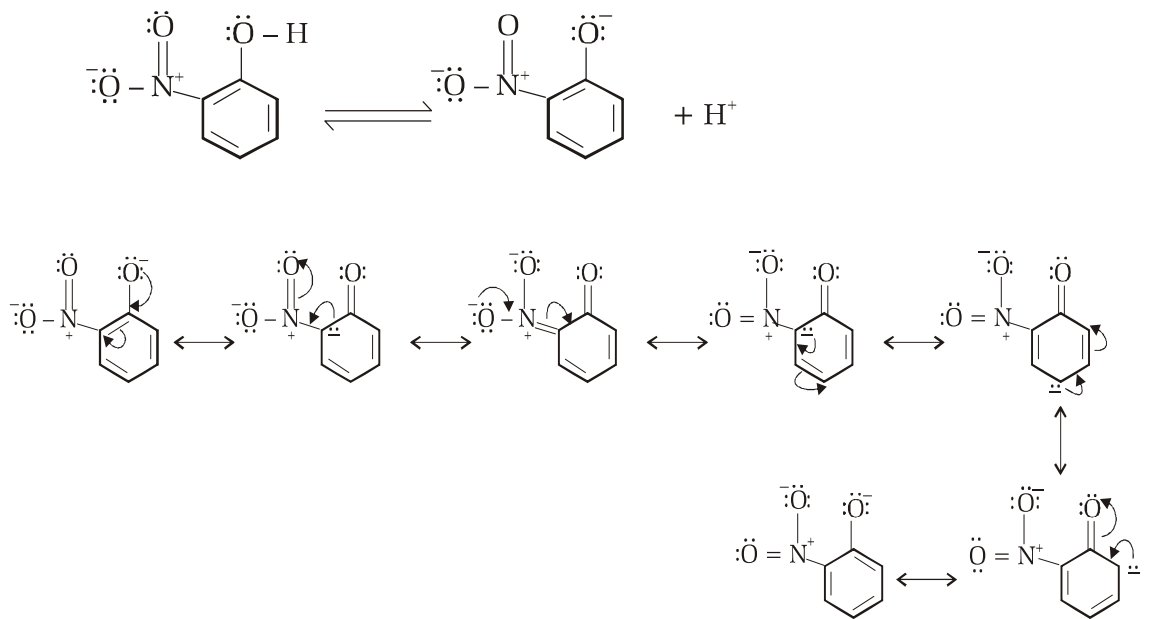
□ ඊනෝල්ට වඩා නයිට්‍රෝනෝල් ආම්ලික බව

නයිට්‍රෝනෝල් හි H^+ ඉවත්වීමෙන් පසු නයිට්‍රෝනෝරි ඇනායනයේ සෘණ ආරෝපණය එහි සම්ප්‍රයුක්ත ව්‍යුහ මගින් වඩාත් හොඳින් විස්ථානගත කරවන බැවින් එම ඇනායනය ස්ථායීතාවයෙන් වඩාත් ඉහළ වේ.

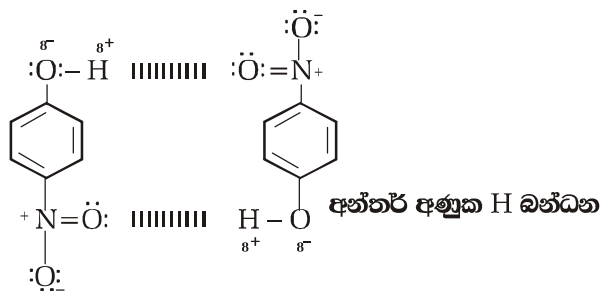
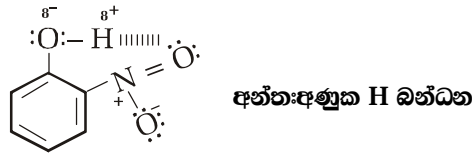
නයිට්‍රෝනෝල්, ඊනෝල්ට වඩා ආම්ලිකතාවයෙන් වැඩිවීමට මෙය හේතු වේ.



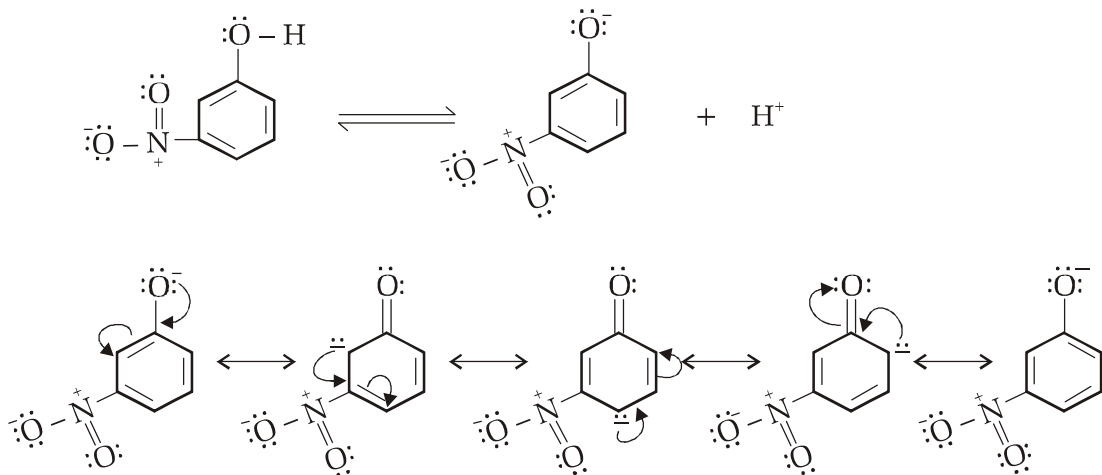
නයිට්‍රොකාණ්ඩය ඕනෑම ස්ථානයේ ඇතිවිටද H^+ ඉවත්වීමෙන් පසු සෑදෙන නයිට්‍රෝනෝරි ඇනායනයේ (-) ආරෝපණය එහි සම්ප්‍රයුක්ත ව්‍යුහ මගින් ඉතා හොඳින් විස්ථානගත කරවයි.



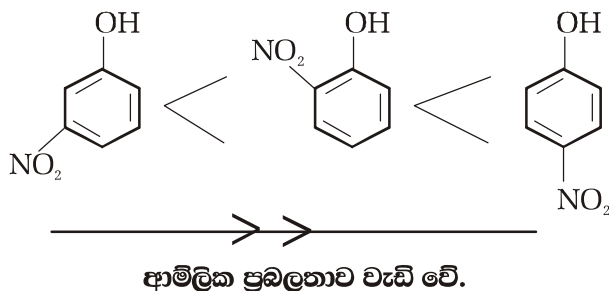
නමුත් ඕනෑම හයිඩ්‍රොලීතෝල් හි හයිඩ්‍රොකාණ්ඩය හා OH කාණ්ඩය අතර ඇතිවන අන්තඃඅණුක H බන්ධනය හේතුවෙන් H⁺ ඉවත්වීම දුර්වල වේ.



නමුත් මෙයට හයිඩ්‍රොලීතෝල් හි H⁺ ඉවත් වීමෙන් පසු සෑදෙන ලීතේට් ඇනායනයේ (-) ආරෝපණය හයිඩ්‍රොකාණ්ඩය හරහා විස්ථානගත නොවන බැවින් එහි සම්ප්‍රයුක්ත ව්‍යුහ ගණන සාපේක්ෂව අඩු ය. එබැවින් මෙයට හයිඩ්‍රොලීතෝල්හි ආම්ලිකතාව අඩු වේ.



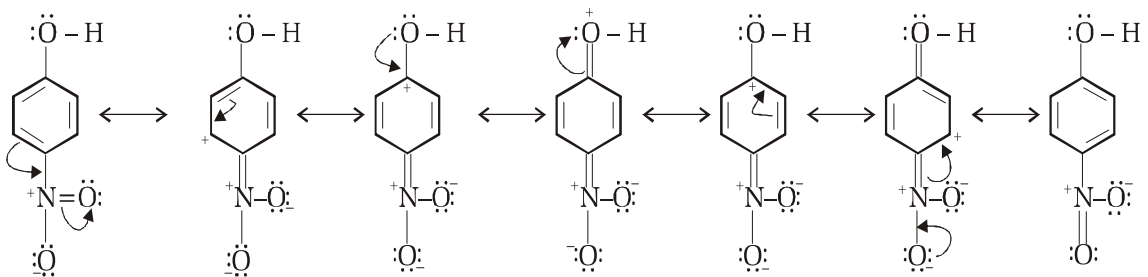
මේ අනුව ආම්ලික ප්‍රබලතා විචලනය පහත ආකාර වේ.



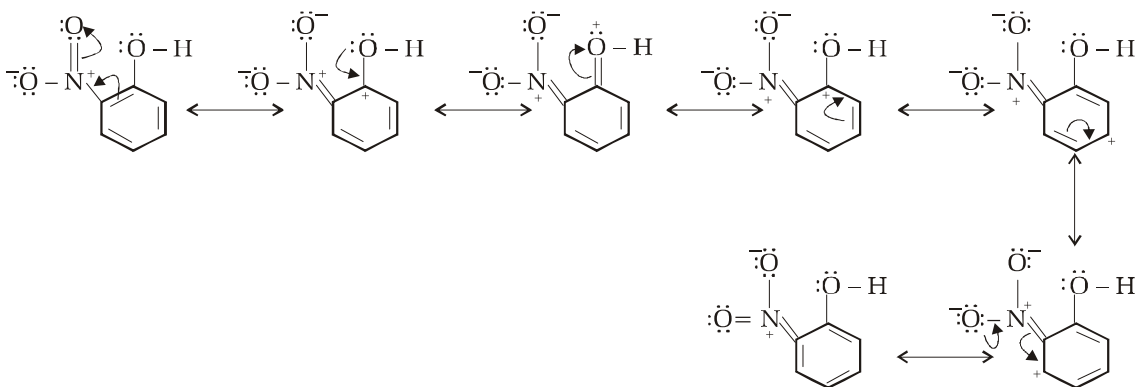
වමෙන්ම නයිට්‍රොකාණ්ඩයක් ප්‍රබල ආකර්ශකයක් බැවින් එයින් ඇති කරන ආකර්ශන බලපෑම හේතුවෙන් O - H කාණ්ඩයේ ධ්‍රැවීකරණය වැඩි වී ආම්ලිකතාවය වැඩි වන බවද සැලකිය හැක.

නයිට්‍රොකාණ්ඩය පැරා හා ඕතො ස්ථානවල ඇතිවිට ඊනෝල්හි O මත + ආරෝපණයක් ඇතිවෙමින් OH කාණ්ඩයේ ධ්‍රැවීකරණය වැඩි වන බව පහත ආකාරයට පෙන්වා දිය හැක.

□ පැරා නයිට්‍රොහීනෝල්

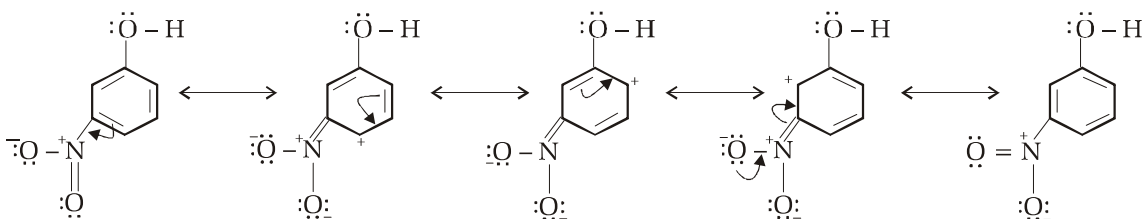


□ ඕතො නයිට්‍රොහීනෝල්

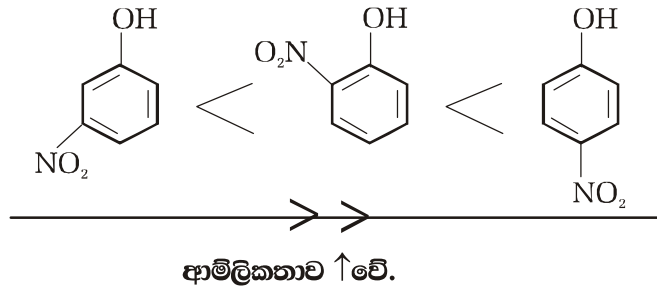


නමුත් නයිට්‍රොකාණ්ඩය මෙටා ස්ථානයේ ඇතිවිට ආකර්ශන ගුණය සාපේක්ෂව දුර්වල වන බව පහත ආකාරයට පෙන්වා දිය හැක.

□ මෙටො නයිට්‍රොහීනෝල්

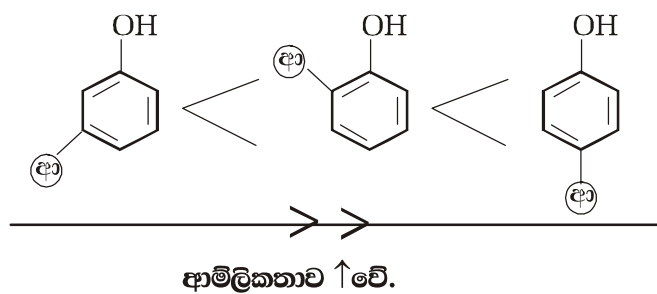
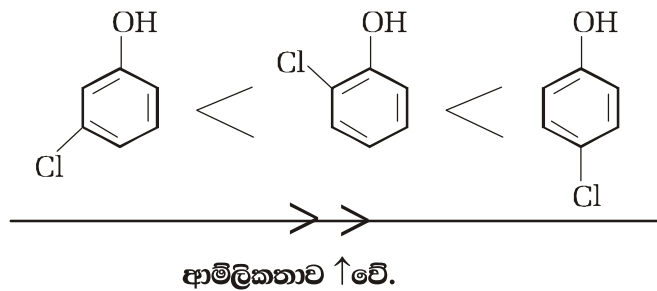


ඒ අනුව නයිට්‍රොකාණ්ඩය පවතින ස්ථානය අනුව ආම්ලික ප්‍රබලතාව විචලනය පහත ආකාරයට වන බව හඳුනාගත හැකිය.



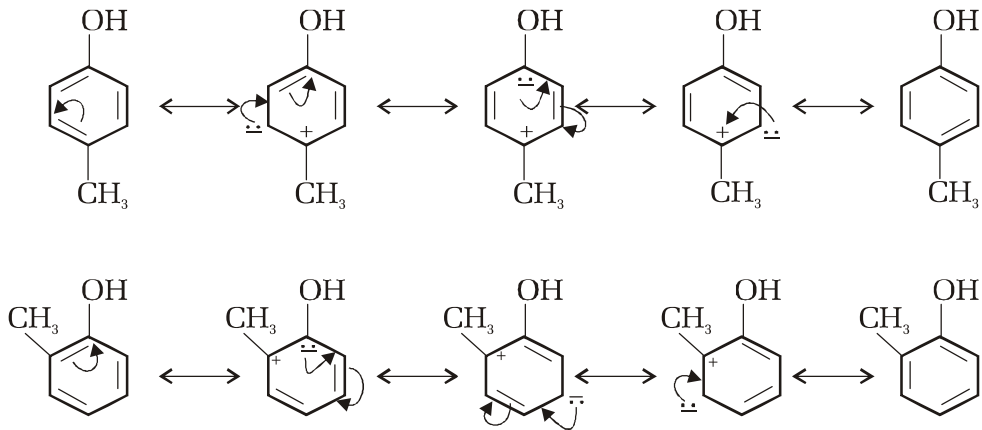
නයිට්‍රොකාණ්ඩය පමණක් නොව ඕනෑම ආකර්ශක කාණ්ඩයක් ඇතිවී ඇතිවන බලපෑම් මේ ආකාර වේ. එනම් ආකර්ශක කාණ්ඩය පැරා ස්ථානයේ ඇති විට ආකර්ශක ගුණය උපරිම වන බැවින් ආම්ලිකතාවය ඉහල වේ.

ආකර්ශක කාණ්ඩය මෙටා ස්ථානයේ ඇතිවී බලපෑම අවම වන බැවින් ආම්ලිකතාවය අවම විය යුතුය.

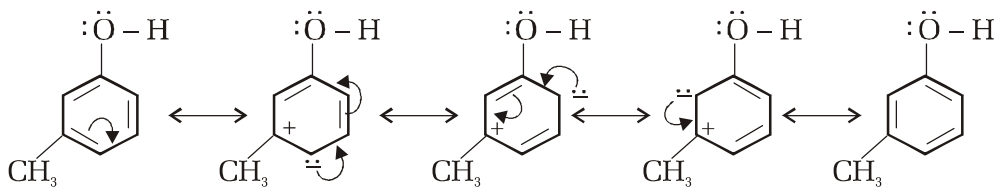


එලෙසටම විකර්ශක කාණ්ඩ බැඳී ඇති විට ද විකර්ශක බලපෑම හේතුවෙන් OH කාණ්ඩයේ ධ්‍රැවීකරණය අඩු වෙමින් H^+ ඉවත්වීමේ හැකියාව අඩු වේ. එවිට ආම්ලිකතාව අඩු වේ.

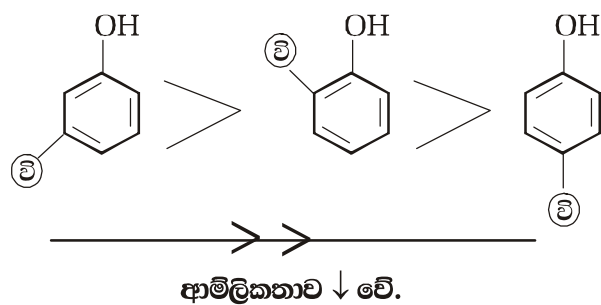
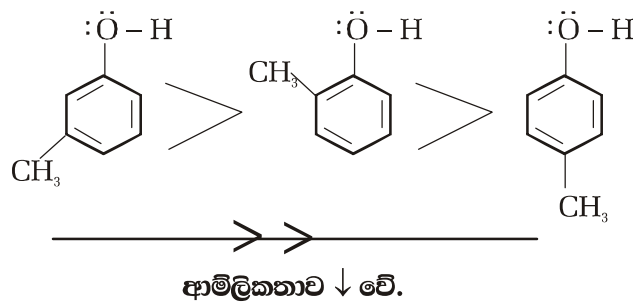
විකර්ශක කාණ්ඩය පැරා / ඕනෑම ස්ථාන වල ඇති විට ඊනෝල් හි O සම්බන්ධ වී ඇති C පරමාණුව මත (-) ආරෝපිත ස්වභාවයක් ඇති වන බැවින් විකර්ශනය ඉහළ වේ. එවිට H^+ ඉවත්වීමේ හැකියාව අඩු වෙමින් ආම්ලිකතාවය අඩු වේ.



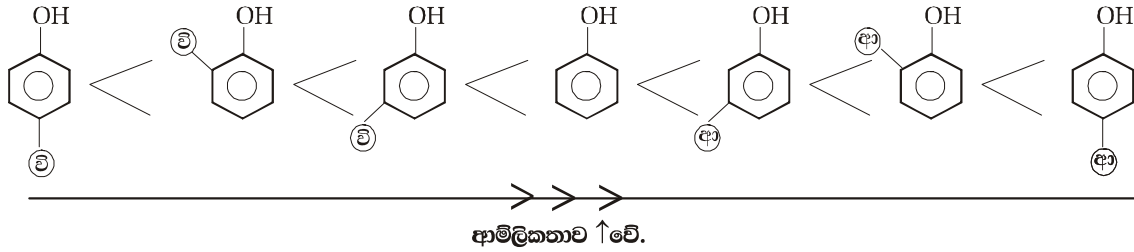
නමුත් විකර්ශක කාණ්ඩ මෙවා ස්ථානයේ ඇතිවිට බලපෑම සාපේක්ෂව අඩු වේ. විකර්ෂක බලපෑම අඩු වන බැවින් H^+ ඉවත්වීමේ හැකියාව ඉහල යයි. එනම් විකර්ශක කාණ්ඩය මෙවා ස්ථානයේ ඇතිවිට සාපේක්ෂව ආම්ලිකතාව වැඩි වේ.



ඒ අනුව විකර්ශක කාණ්ඩ බැඳී ඇති ස්ථානය අනුව ටීනෝල්හි ආම්ලිකතා විචලනය පහත ආකාර වේ.



ඒ අනුව ෆීනෝල්ට බැඳී ඇති කාණ්ඩ අනුව ආම්ලික ප්‍රබලතා විචලනය පහත ආකාර වේ.



කාබොක්සිලික් අම්ල වල ආම්ලිකතාව

කාබොක්සිලික් අම්ල වල H^+ ඉවත් වීමෙන් පසු සෑදෙන කාබොක්සිලේට් අනායනයේ ආරෝපණය එහි සම්ප්‍රයුක්ත ව්‍යුහ මගින් විස්ථාපනය කරවයි.

එහි පවතින්නේ සම්ප්‍රයුක්ත ව්‍යුහ අඩු ගණනක් වුවද (-) ආරෝපණය විස්ථාපනය වන්නේ විද්‍යුත් සෘණතාවයන් සමාන ඔක්සිජන් පරමාණු මත පමණක් වන බැවින් කාබොක්සිලේට් අනායනය ඉහල ස්ථායීතාවයක් සහිත වේ.

එම නිසා කාබොක්සිලික් අම්ල ෆීනෝල්ට වඩා ඉහළ ආම්ලිකතාවයක් දක්වයි.

